

Silicon NPN Transistor

BU110

TV Horizontal Deflection

330V / 8A

DATASHEET

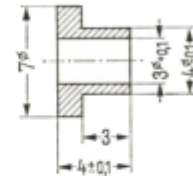
OEM – Siemens

Source: Siemens Databook 1970/71

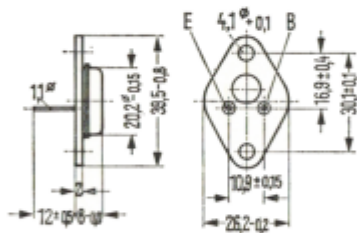
BU 110**NPN-Leistungsschalt-Transistor
für Fernseh-Horizontal-Ablenk-Endstufen**

BU 110 ist ein dreifach-diffundierter NPN-Silizium-Hochstromschalttransistor im Gehäuse 3 A 2 DIN 41872 (TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Der Transistor ist besonders für den Einsatz in Horizontal-Ablenk-Endstufen nach dem Pumptransistorprinzip geeignet.

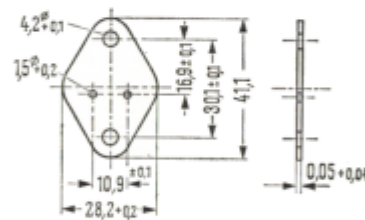
Typ	Bestellnummer
BU 110	Q62702-U83
Glimmerscheibe	Q62901-B11-A
Isoliernippel (Teflon)	Q62901-B13-C



Isoliernippel (Teflon)
für Temp. bis 200 °C
Maßstab 2 : 1



Gewicht etwa 16,5 g Maße in mm



Glimmerscheibe

Grenzdaten

Kollektor-Emitterspannung	U_{CEO}	150	V
Kollektor-Basisspannung	U_{CBS}	330	V
Emitter-Basisspannung	U_{EBS}	6	V
Kollektorspitzenstrom	I_{Cmax}	8	A
Basisspitzenstrom	I_{Bmax}	2,5	A
Sperrschichttemperatur	T_j	150	°C
Lagertemperatur	T_s	150	°C
Gesamtverlustleistung ($T_G \leq 75^\circ\text{C}$)	P_{tot}	25	W

Wärmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Transistorgehäuse	R_{thJG}	≤ 3	grad/W
---	------------	----------	--------

BU 110**Statische Kenndaten** ($T_U = 25^\circ\text{C}$)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung ($I_{CEO} = 20\text{ mA}$)	$U_{(BR)CEO}$	> 150	V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung ($I_{CBS} = 1\text{ mA}$)	$U_{(BR)CBS}$	> 330	V
Kollektor-Emitter-Reststrom ($U_{CES} = 330\text{ V}$; $T_U = 150^\circ\text{C}$)	I_{CES}	< 15	mA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung ($I_C = 6\text{ A}$; $I_B = 0,75\text{ A}$)	U_{CEsat}	< 1,5	V
Basis-Emitter-Sättigungsspannung ($I_C = 6\text{ A}$; $I_B = 0,75\text{ A}$)	U_{BEsat}	< 1,5	V
Statische Stromverstärkung ($I_C = 6\text{ A}$; $U_{CE} = 1,5\text{ V}$)	B	> 8	

Dynamische Kenndaten ($T_U = 25^\circ\text{C}$)

Transitfrequenz ($I_C = 200\text{ mA}$; $U_{CE} = 10\text{ V}$)	f_T	15	MHz
Schaltzeit ($I_C = 6\text{ A}$; $I_{B1} = I_{B2} = 1\text{ A}$; $U_{CE} = 12\text{ V}$)	t_f	1	μs